

2SD851

2SD851

**NPN エピタキシャル形シリコントランジスタ
(ダーリントン接続)
低速度大電流スイッチング用
工業用**

**NPN Silicon Epitaxial Transistor
(Darlington)
Low Speed High Current Switching
Industrial Use**

- ダーリントン接続であるため直流電流増幅率が高い。
High DC current gain.
- コレクタ飽和電圧が低い。
Low collector saturation voltage.
- コンピュータ端末機器, パルスモータドライバ, リレードライバ等にICの出力から直接ドライブする用途に最適です。

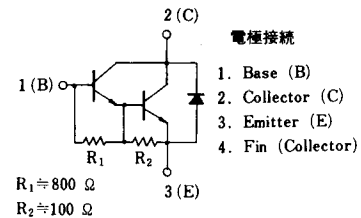
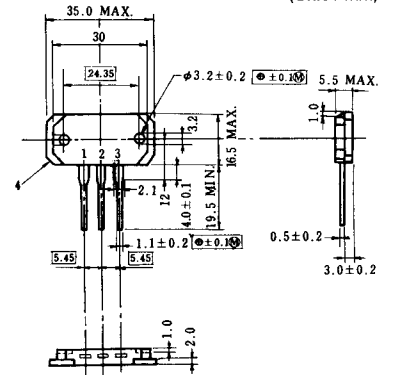
絶対最大定格／ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS (Ta=25 °C)

項 目	略 号	定 格	単 位
コレクタ・ベース間電圧	V _{CB0}	150	V
コレクタ・エミッタ間電圧	V _{CE0}	100	V
エミッタ・ベース間電圧	V _{EB0}	8.0	V
コレクタ電流	I _{C(DC)}	±10	A
コレクタ電流	I _{C(pulse)*}	±20	A
ベース電流	I _{B(DC)}	1.0	A
全 損 失	P _{T(Ta=25 °C)}	3.0	W
全 損 失	P _{T(Tc=25 °C)}	80	W
ジャンクション温度	T _j	150	°C
保 存 温 度	T _{stg}	-55~+150	°C

*PW≤300 μs, duty cycle≤10 %

外形図／PACKAGE DIMENSIONS

(Unit : mm)



電気的特性／ELECTRICAL CHARACTERISTICS (Ta=25 °C)

項 目	略 号	条 件	MIN.	TYP.	MAX.	単 位
コレクタシャ断電流	I _{CB0}	V _{CB} =100 V, I _E =0			10	μA
直 流 電 流 増 幅 率	h _{FE}	V _{CE} =2.0 V, I _C =10 A*	1000	3000		
コレクタ飽和電圧	V _{CE(sat)}	I _C =10 A, I _B =25 mA*		1.2	1.5	V
ベース飽和電圧	V _{BE(sat)}	I _C =10 A, I _B =25 mA*		1.6	2.0	V
ターンオン時間	t _{on}	I _C =10 A, I _{B1} =-I _{B2} =25 mA R _L =5.0 Ω, V _{CC} ≒50 V		1		μs
蓄 積 時 間	t _{stg}			5		μs
下 降 時 間	t _f			2		μs

*パルプ測定 PW≤350 μs, duty cycle≤2 %/ Pulsed